مدارهای الکتریکی و الکترونیکی فصل دوازدهم: ترانزیستور (ادامه)

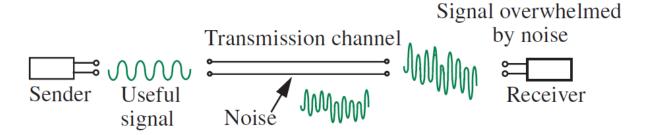
استاد درس: محمود ممتازپور ceit.aut.ac.ir/~momtazpour

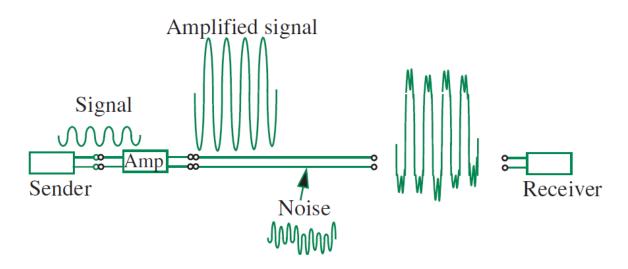
فهرست مطالب

- □ مدل ترانزیستور به عنوان تقویت کننده
 - □ سیگنال بزرگ
 - 🗖 سيگنال كوچك
 - □ تحلیل DC و AC ترانزیستورها
 - □ پیکربندیهای مختلف

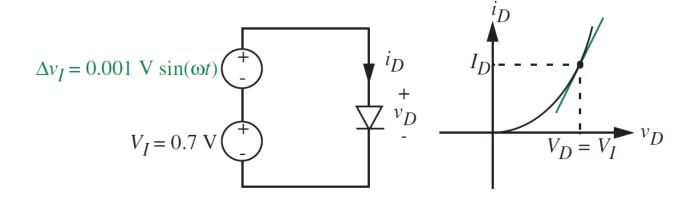
کاربردهای ترانزیستور

در مدارهای آنالوگ به عنوان تقویتکننده





رفتار غیرخطی دیود



□ با استفاده از مدل غیرخطی برای محاسبه جریان دیود داریم:

$$\square i_D = I_S[e^{(V_I + \Delta v_I)/V_{TH}} - 1]$$

رفتار غیرخطی دیود

ا با استفاده از بسط تیلور حول V_I داریم:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2!}f''(a)(x - a)^2 + \cdots$$

$$i_D = f(x) = I_S[e^{x/V_{TH}} - 1]$$

$$\mathbf{v} = V_I + \Delta v_I$$

$$\square$$
 $a = V_I$

$$\square i_D = I_S[e^{(V_I + \Delta v_I)/V_{TH}} - 1]$$

$$= I_{S}(e^{V_{I}/V_{TH}} - 1) + I_{S}e^{V_{I}/V_{TH}} \left[\frac{\Delta v_{I}}{V_{TH}} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta v_{I}}{V_{TH}} \right)^{2} + \cdots \right]$$

$$\approx I_S(e^{V_I/V_{TH}}-1)+\frac{I_D}{V_{TH}}\Delta v_I$$

مدل سیگنال کوچک و سیگنال بزرگ

بخش AC جریان دیود با بخش AC منبع رابطه تقریباً خطی دارد.

یعنی دیود در برابر یک سیگنال کوچک رفتاری خطی دار د و مانند یک مقاومت با

> Slope of the the operating point V_D , I_D

مقدار $\frac{V_{TH}}{I}$ عمل میکند. به این

مدل خطی، مدل سیگنال Δi_D given by

 Δv_D

 $\Box i_D \approx I_S(e^{V_I/V_{TH}} - 1) + \frac{I_D}{V_{TH}} \Delta v_I$

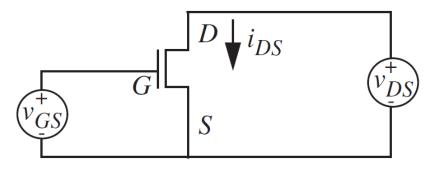
بخش DC جریان دیود با بخش DC منبع رابطه غیرخطی دارد. یعنی دیود در برابر یک سیگنال بزرگ رفتاری غیرخطی دارد.

به این مدل غیرخطی که قبلا نیز دیده بودیم، مدل سیگنال

بزرگ گویند.

مدل سیگنال بزرگ MOSFET

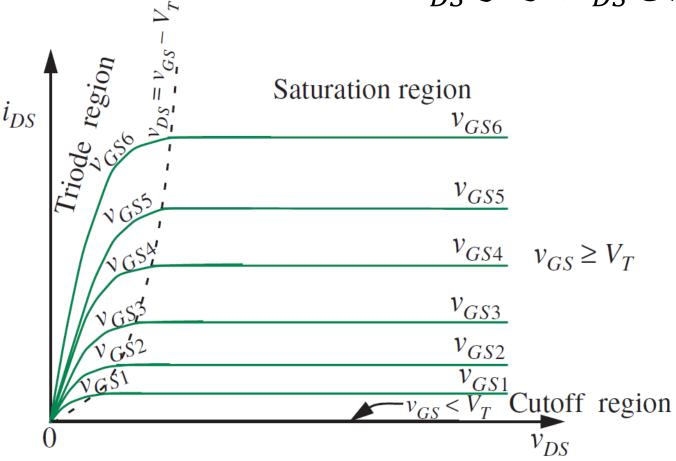
□ مدل مرتبه اول شاکلی Shockley



$$I_{ds} = egin{cases} 0 & V_{gs} < V_t & ext{Eds} \\ K \left(V_{gs} - V_t - rac{V_{ds}}{2}
ight)V_{ds} & V_{ds} < V_{gs} - V_t & ext{Eds} \\ rac{K}{2} \left(V_{gs} - V_t
ight)^2 & V_{ds} > V_{gs} - V_t & ext{Eds} \end{cases}$$
 اشباع

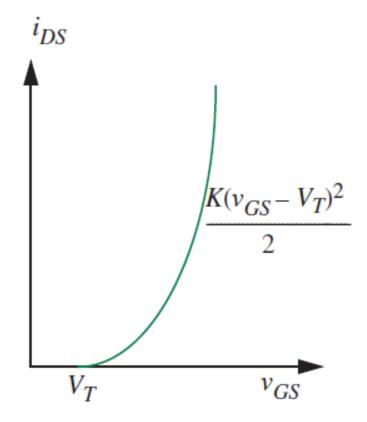
مشخصه ولتاژ-جریان MOSFET

v_{DS} با ولتاثر رابطه جریان i_{DS} با ولتاثر



مشخصه ولتاژ-جریان MOSFET

v_{GS} با ولتار i_{DS} رابطه جریان رابطه



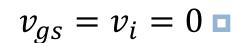
valid when $v_{DS} \ge v_{GS} - V_T$

تحلیل DC ترانزیستور DC

- □ روابط KVL دو طرف ترانزیستور را بنویسید.
- ا با استفاده از این روابط، ولتا V_{gs} را به دست آورید. (جریان گیت همیشه صفر است).
 - $I_{ds}=0$:اگر کا باشد، ترانزیستور قطع است $V_{gs}< V_t$ اگر ا
 - اگر $V_{gs} > V_t$ باشد، یا اشباع است یا خطی \sim
 - $I_{ds} = rac{K}{2} ig(V_{gs} V_t ig)^2$: فرض میکنیم اشباع است است
 - ولتاثر V_{ds} را به دست آورده و شرط اشباع بودن را چک می کنیم:
 - $V_{ds} > V_{gs} V_t$
 - $I_{ds}=K\left(V_{gs}-V_{t}-rac{V_{ds}}{2}
 ight)V_{ds}$: اگر تناقض داشت خطی است -

$$(K = 0.5 \frac{mA}{V^2}, V_t = 2, v_i = 0)$$
 را بیابید. V_o را بیابید.

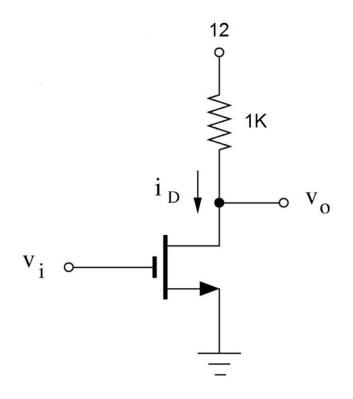
□ روابط KVL دو طرف:



$$-12 + 1000i_D + v_{ds} = 0$$

$$v_{gs} < v_t$$
 پس قطع است: $v_{gs} < v_t$

$$v_{ds} = 12 \, \square$$



$$(K)^2 = 0.5 \frac{mA}{V^2}, V_t = 2, v_i = 6)$$

- را بیابید. V_o
- □ روابط KVL دو طرف:

$$v_{gs} = v_i = 6 \square$$

$$-12 + 1000i_D + v_{ds} = 0$$

پس یا خطی است یا اشباع
$$v_{gs} > V_t$$
 اسباع

فرض میکنیم اشباع است:

$$i_D = \frac{K}{2} (v_{gs} - V_t)^2 = 4mA \rightarrow v_{ds} = 12 - 4 = 8 \square$$

$$v_{ds} > v_{gs} - V_t = 4 \square$$

$$(K=0.5rac{mA}{V^2},V_t=2,v_i=12)$$
 را بیابید. V_0 را بیابید. V_0 دو طرف:

- $v_{as} = v_i = 12 \quad \blacksquare$
- $-12 + 1000i_D + v_{ds} = 0$
- یا اشباع است یا خطی $v_{gs} > V_t$ یا
 - 🗖 فرض اشباع:

$$i_D = \frac{K}{2} (v_{gs} - V_t)^2 = 25mA \rightarrow v_{ds} = 12 - 25 = -13$$

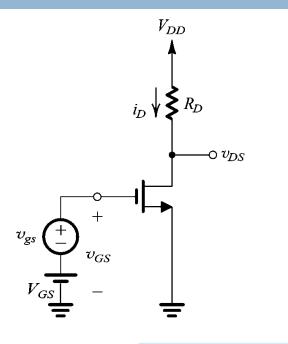
- $v_{ds} < v_{gs} V_t = 10$
 - 🗖 فرض خطی:

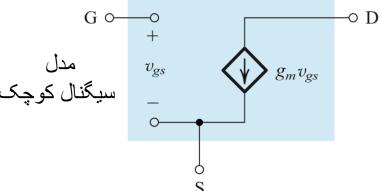
$$i_D = K\left(v_{gs} - V_t - \frac{v_{ds}}{2}\right)v_{ds} = 0.25\left(20v_{ds} - v_{ds}^2\right) \xrightarrow{use\ DS\ KVL} \quad \blacksquare$$

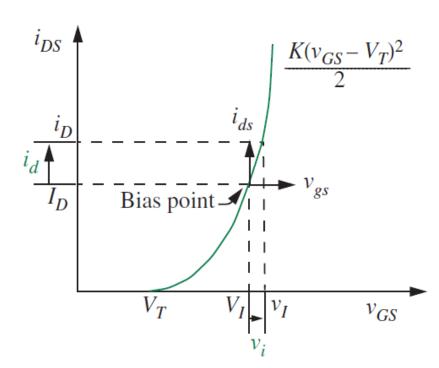
$$v_{ds} = 21.8 \times$$

$$v_{ds} = 2.2 < 10 \checkmark$$

مدل سیگنال کوچک MOSFET

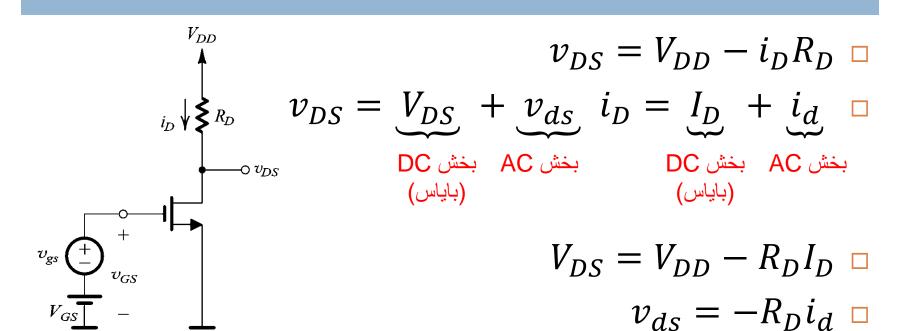






در اشباع: $g_m = \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}}|_{v_{GS}=V_{GS}} = K(V_{GS}-V_t)$

جداسازی تحلیل DC از AC

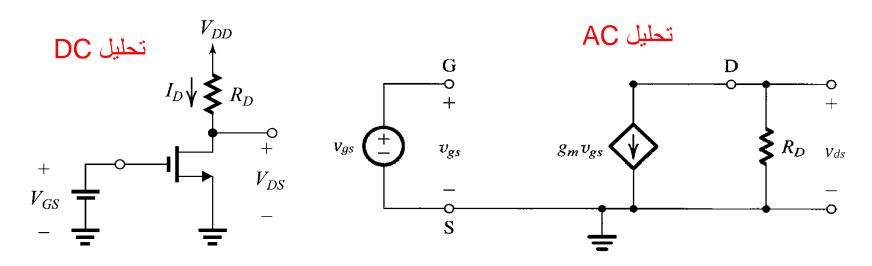


- □ پاسخ به بخش DC ورودی DC است.
- □ پاسخ به بخش AC ورودی هم AC است.
- □ بنابراین میتوان تحلیل DC و AC را جداگانه انجام داد.

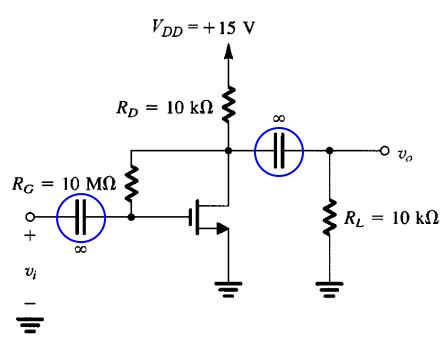
جداسازی تحلیل DC از AC

$$\square v_{ds} = -R_D i_d = -R_D g_m v_{gs}$$

$$\square \ A_v = rac{v_{ds}}{v_{gs}} = -g_m R_D$$
 بهره ولتاژ



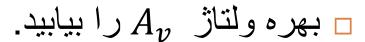
چرا سر مقاومت R_D به زمین وصل شده است؟



- □ دلیل استفاده از خازنهای کویلینگ:
- خازن در مقابل ولتاژهای DC مدار باز میشود. بنابراین اگر چند طبقه از این مدارها را به هم ببندیم، بایاس DC یک طبقه بر دیگری تاثیری ندارد و طراحی تقویتکننده راحت تر میشود.
- اتصال کوتاه است ($0 \approx \frac{1}{cj\omega}$ برای ΔC اتصال کوتاه است (ΔC برای فرکانسهای بالا). بنابراین سیگنال ΔC از خازن رد می شود.

مثال (ادامه)

$$(K=0.25rac{mA}{{
m V}^2},V_t=1.5)$$
 بهره ولتاث A_v را بیابید.



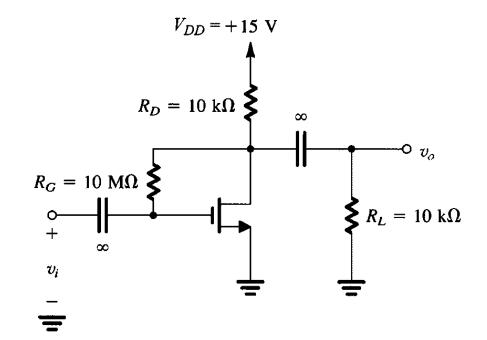




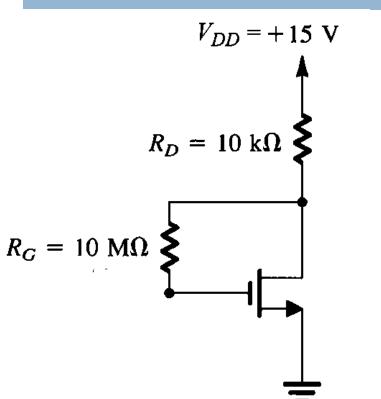
بایاس و g_m را بیابید.

□ تحلیل AC

- □ خاز نها اتصال کو تاهند
 - بهره A_n را بیابید.



مثال (ادامه: تحلیل DC)



$$(K = 0.25 \frac{mA}{V^2}, V_t = 1.5) \square$$

$$I_G = 0 \rightarrow V_{GS} = V_{DS} \square$$

$$V_{DS} = 15 - 10000I_{DS} \square$$

$$I_{DS} = 0 \rightarrow V_{DS} = 15 \square$$

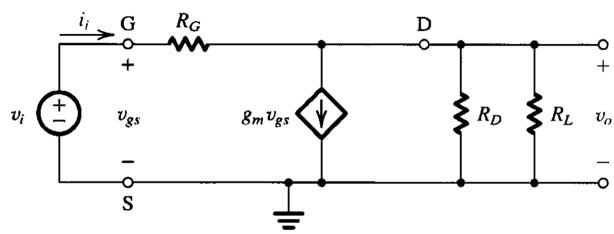
$$V_{GS} = 15 > V_t \times \square$$

$$I_{DS} = 0.125(V_{GS} - 1.5)^2 \rightarrow I_{DS} = 1.06mA$$

$$V_{GS} = V_{DS} = 4.4V$$

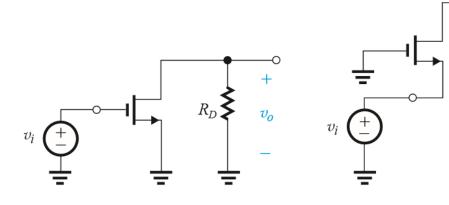
$$g_m = \beta(V_{GS} - V_t) = 0.725 mA/V$$

مثال (ادامه: تحلیل DC)



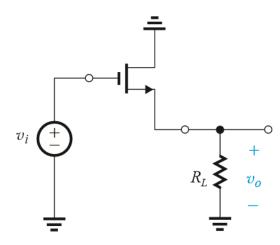
- $\square R'_L = R_D || R_L = 5K$
- $\square v_o = R'_L(i_i g_m v_i)$
- $\Box v_i = R_G i_i + v_o$
- $\Box \rightarrow A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{1 g_m R_G}{1 + R_G / R_L'} \approx -g_m R_L' = -3.625$

پیکربندیهای مختلف MOSFET



(a) Common Source (CS)

(b) Common Gate (CG)



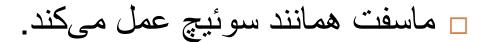
(c) Common Drain (CD)

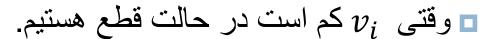
ماسفت به عنوان سوئیچ



$$v_i = 0 \rightarrow v_o = 12$$

$$v_i = 12 \rightarrow v_o = 2.2 \square$$

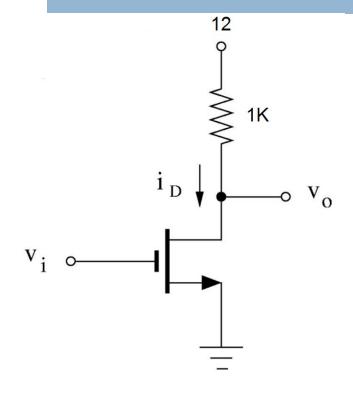




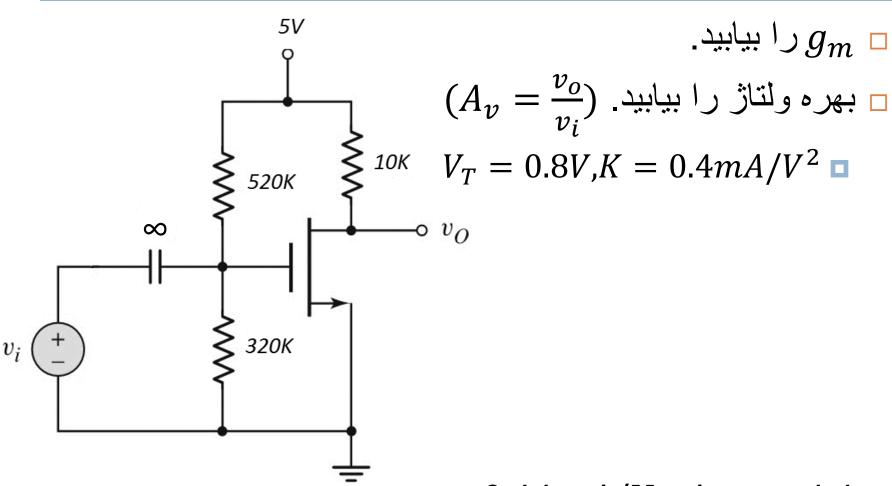
وقتی
$$v_i$$
 زیاد است در حالت خطی هستیم.

$$v_i = 0 \rightarrow v_o = 1$$

$$v_i = 1 \rightarrow v_o \approx 0$$

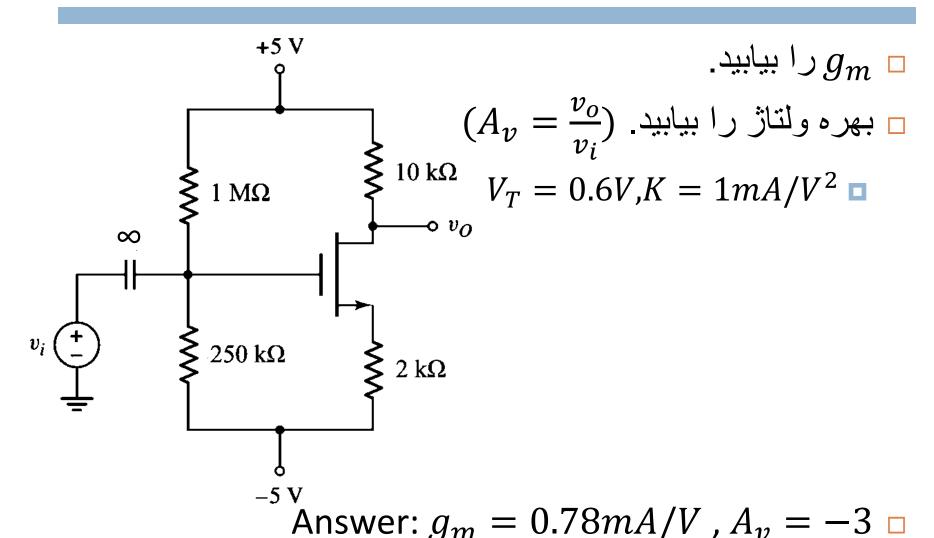


تمرین کلاسی 1 (سورس مشترک)



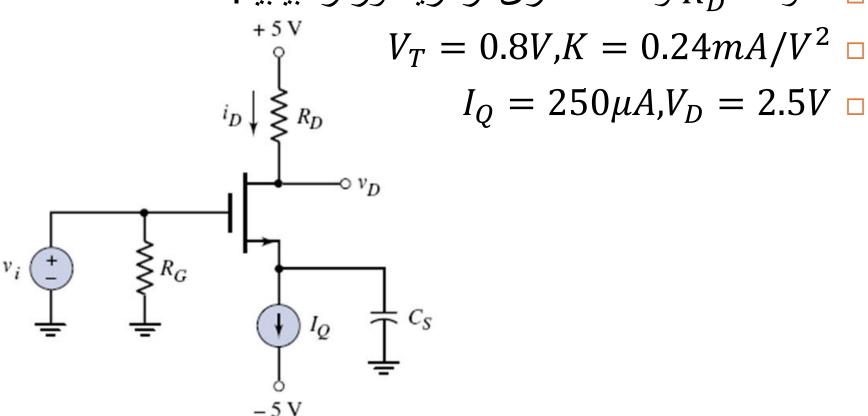
Answer: $g_m = 0.44 mA/V$, $A_v = -4.4$ \square

تمرین کلاسی 2 (سورس مشترک)



تمرین کلاسی 3 (سورس مشترک)

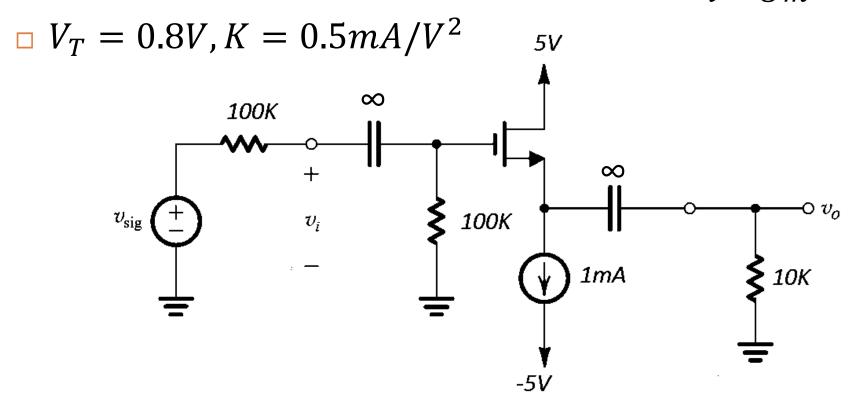
مقاومت R_D و حالت کاری ترانزیستور را بیابید \square



Answer: $R_D = 10K\Omega$, saturation \square

تمرین کلاسی 4 (درین مشترک)

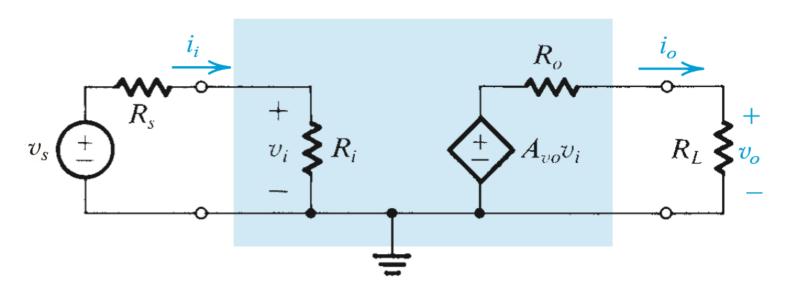
و A_{v} را بیابید. g_{m}



Answer: $g_m=1mA/V$, $A_v=0.45$ \square

مقاومت ورودی و خروجی

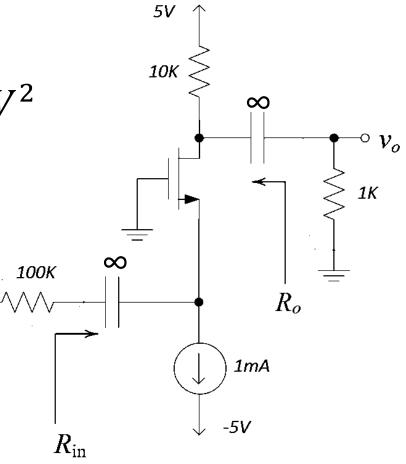
- □ در یک تقویت کننده، معمولا میخواهیم:
- $v_ipprox v_s$ مقاومت ورودی R_i بزرگی داشته باشیم تا
- $v_opprox A_vv_i$ مقاومت خروجی R_o کوچکی داشته باشیم تا مقاومت ح



تمرین کلاسی 5 (گیت مشترک)

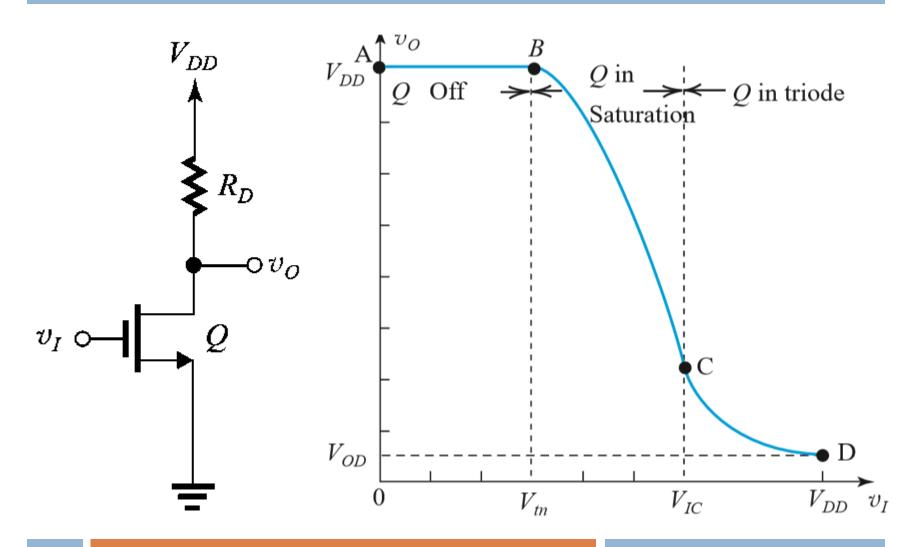
- $lue{}$ Find g_m and A_v
- \square Find R_{in} , R_o

 $V_T = 0.8V, K = 0.5mA/V^2$



 $v_{
m sig}$

گیت اینورتر NMOS با بار مقاومتی



گیت اینورتر CMOS

